

Метка	Название	Структурное подразделение	ЗЕТ	ч	Семестры								Практическая подготовка	Компетенции									
					1 курс				2 курс														
					1 18 нед (ТО: 18 нед)	2 17 нед (ТО: 17 нед)	3 18 нед (ТО: 18 нед)	4 5 нед (ТО: 5 нед)	1 18 нед (ТО: 18 нед)	2 17 нед (ТО: 17 нед)	3 18 нед (ТО: 18 нед)	4 5 нед (ТО: 5 нед)											
Б1.ДВ.2.6 Ф	Б1.ДВ.2.6.1 Сенсоры и Датчики в микроэлектронике Б1.ДВ.2.6.2 Материаловедение	27 3	3	108	40	8	32	32	3(36)								УК-1						
Б1.ДВ.2.7 Ф	Б1.ДВ.2.7.1 Цифровая обработка сигналов Б1.ДВ.2.7.2 Телевизионные и космические системы	27 3	2	72						32	16	16	40	3			ПК-10						
Б1.ДВ.2.8 Ф	Б1.ДВ.2.8.1 Электромагнитная совместимость Б1.ДВ.2.8.2 Интегральные СВЧ системы	27 3	3	108						40	8	32	68	3			ПК-9						
Б1.ДВ.2.9 Ф	Б1.ДВ.2.9.1 Основы радиационных технологий Б1.ДВ.2.9.2 Методы повышения радиационной стойкости, сбое- и отказоустойчивости современной цифровой наноэлектроники	27 3	2	72						30	15	15	42	3			ПК-1, ПК-5, ПК-6 ПК-3, ПК-4						
Б1.ДВ.2.10 Ф	Б1.ДВ.2.10.1 Элементы микро- и наноэлектроники Б1.ДВ.2.10.2 Экстремальная электроника	27 3	3	108						45	7	23	15	27	3(36)		15 ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9						
Б1.ДВ.2.11 Ф	Б1.ДВ.2.11.1 Элементы самоустойчивых систем Б1.ДВ.2.11.2 Технологии наноэлектроники	3 27	3	108						48	8	40	24	3(36)			ПК-8						
Б1.ДВ.2.12 Ф	Б1.ДВ.2.12.1 Надежность и радиационная стойкость интегральных схем Б1.ДВ.2.12.2 Основы ядерной электроники	27 3	6	216						48	16	16	16	24	3(36), К/л	49	7	42	23	3(36)	ПК-6		
Б1.ДВ.2.13 Ф	Б1.ДВ.2.13.1 Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле Б1.ДВ.2.13.2 Проектирование электронных систем	27 3	7	252						48	8	24	16	60	3(36)	21	7	14	51	3(36), К/л	ПК-7, ПК-15.1		
Б2	Практика		39	1404																			
Б2.ОД	Базовая часть		21	756																			
Б2.ОД.1.О	Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)	3	3	108						30			78	3							108	ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15.1	
Б2.ОД.2.О	Производственная практика (научно-исследовательская работа)	3	18	648	16					272	3(36)	15			93	3(36)	16				128	3(36)	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УКД-1, УКД-2, ПК-15.1
Б2.ДВ	Вариативная часть		18	648																			
Б2.ДВ.1.Ф	Производственная практика (педагогическая)	3	3	108											108	3						108	УК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Метка	Название	Структурное подразделение	ЗЕТ	ч	Семестры																Практическая подготовка	Компетенции									
					1 курс				2 курс																						
					1 18 нед (ТО: 18 нед)				2 17 нед (ТО: 17 нед)				3 18 нед (ТО: 18 нед)				4 5 нед (ТО: 5 нед)														
Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт								
Б2.ДВ.2 Ф	Производственная практика (преддипломная)	3	15	540																						540	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, УКД-1, УКД-2, ПК-15.1				
Б3	Государственная итоговая аттестация		6	216																								УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, УКД-1, УКД-2, ПК-15.1			
Б3.1 О	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	3	6	216																							216	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, УКД-1, УКД-2, ПК-15.1			
Ф.1 Ф	Факультативы Военная подготовка	20	5	180	264	88	160	672					372	122	190	15	564										90	34	156	918	УК-1, УК-3, УК-6
Итого:					120	4320	1188													1451 ч											
Объем аудиторных занятий (ч/нед)					14,67						21,88						19,11						18								
Максимальная учебная нагрузка (ч/нед)					52						48,71						52						53,4								
Учебная нагрузка в сессию (ч/нед)					36						45						48						36								
Зачет					3						6						6						2								
Зачет с оценкой					1						5						4						2								
Экзамен					3						1						1						1								
Курсовой проект																															
Курсовая работа																															

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела магистратуры

Кружалова О.В.

И. о. Директора ИНТЭЛ

Стриханов М.Н.

Руководитель магистерской программы

Краснюк А.А.